

GS8014

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4")

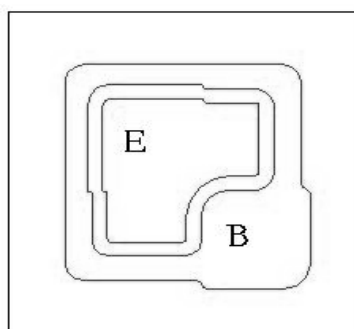
■用 途

- *小信号放大器
- *高增益、低噪声音频驱动器

■特征

- *优越的 h_{FE} 特性
- *低噪声
- *集电极电流: 0.1A
- *与 GS8015 配对
- *有效管芯数(只):54800

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	360 μ m \times 360 μ m
压焊区尺寸	基区 105 μ m \times 105 μ m 发射区 95 μ m \times 95 μ m
芯片厚度	220 \pm 10 μ m
锯片槽宽度	55 μ m
金属层	正面: Al 1.85 \pm 0.15 μ m 背面: Au 1.1 \pm 0.2 μ m

■电特性(Ta=25 $^{\circ}$ C)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	单位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=100\mu A, I_E=0$	40		V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=1mA, I_B=0$	20		V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=100\mu A, I_C=0$	5		V
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=32V, I_E=0$		100	nA
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=4V, I_C=0$		100	nA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=1V, I_C=50mA$	100	400	
集电极--发射极饱和电压	$V_{CE(SAT)}$	$I_C=100mA, I_B=5mA$		0.3	V